

# 學位論文系助審查流程

1. 登入論文系統 <https://cloud.ncl.edu.tw/asia/>

提醒:若系上學制(如成立碩專班)或系名有任何異動,請務必通知圖書館,以便修改系統。

開放時間 館藏查詢 相關連結 防疫專區 Webpac行動版

## 誠徵書庫志工

Stacks management Volunteers Needed  
圖書視聽上架業務、藏書清點及  
下架整理作業、移架業務等

館務公告 活動公告 人力招募

類別	標題	張貼日期
館務公告	<b>重要</b> 110學年度春季借書公告	2021-12-09
館務公告	敬請踴躍申請"110學年第二學期教授指定用書",以利學生借閱課程所需圖書及視聽資料!	2021-12-21
館務公告	110學年度(2022年)訂購電子資源清單,歡迎全校師生多加利用~	2021-12-17

### ◆ 圖書館網頁→電子資源→博碩士論文系統

空間名稱	空間區域	尚有空間[更新]
團體討論室	3F 討論室	2
視聽欣賞室	3F 視聽欣賞室	3
AI練功坊	2F AI練功坊	0
研究小間	3F 研究小間	0

週六/日 09:30~17:30 由阿鼻廣場進入

館藏查詢

館藏查詢系統 (我的書架)

期刊查詢

亞太二十週年特刊

教授指定用書

新書通報

考古羅

電子資源

VOD線上隨選視聽系統

博碩士論文系統 (建議使用chrome)

360Link文獻動態連結服務

AI閱讀專區

Asia University, Taiwan 亞洲大學

Asia University, Taiwan 亞洲大學

Asia University 博碩士論文系統

ndttdcc.ncl.edu.tw/asia/

請注意一般生帳號與在職生帳號不同

論文建構與管理 Submission

論文查詢 Search

最新消息 News

建構流程 Upload Workflow

建構說明 User Guides

下載區 Download

相關連結 Related Links

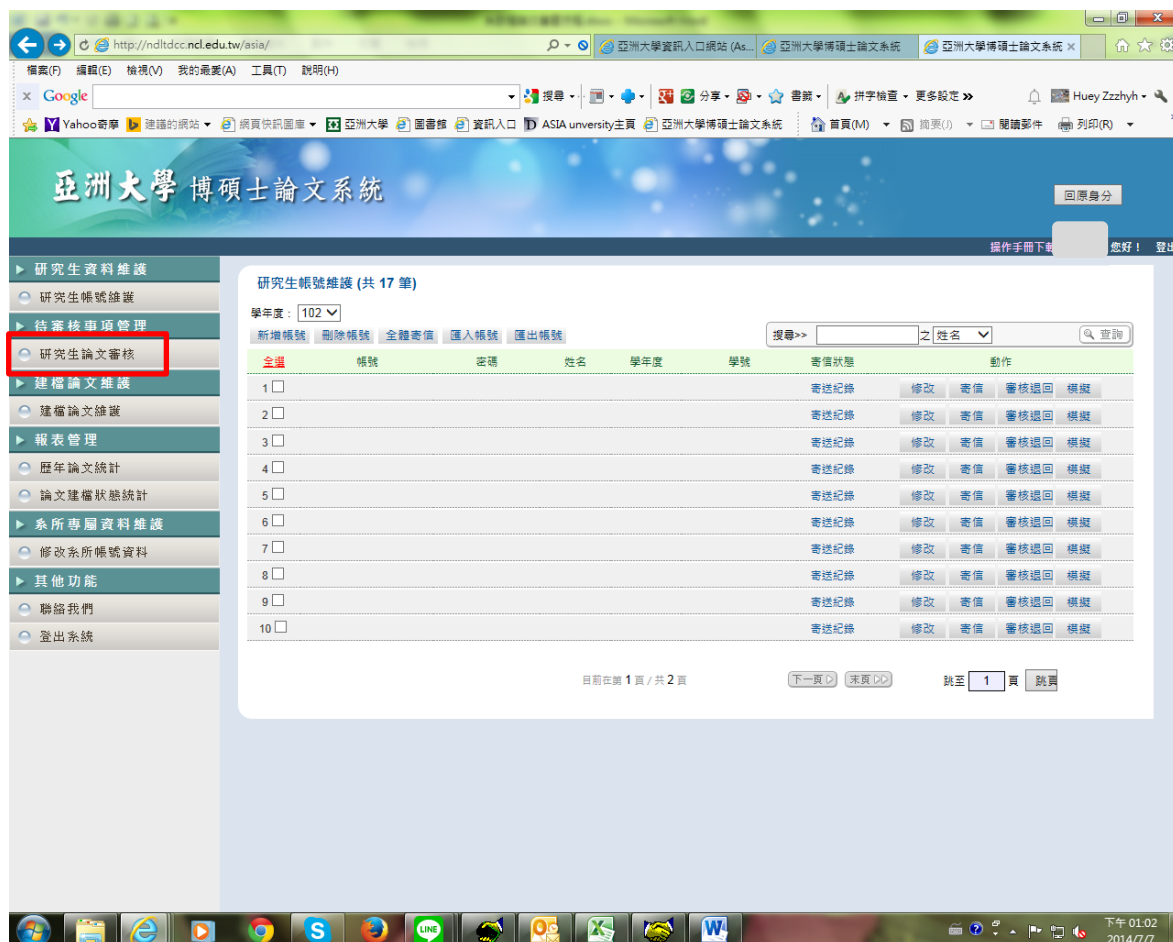
帳號: \_\_\_\_\_

密碼: \_\_\_\_\_

Go

## 2. 點選「研究生論文審核」進行查核

請注意若學生學籍系統是掛在其他系,但就讀是另一系時,則論文系統帳號系所務必與學籍系統一致



## 3. 點選“審核”



## 4. 論文基本資料查核

基本資料	中外文摘要	目錄	參考文獻	電子全文	備份全文
論文種類:	代替論文: 技術報告 (應用科技類)				
研究生中文名:					
研究生外文名:					
論文中文名稱:					
論文外文名稱:					
指導教授:					
中文名:	王大華				
外文名:	WANG, DA-WA				
指導教授E-mail:	jareello@asia.edu.tw				
口試委員:					
中文名:	王大華				
外文名:	WANG, DA-WA				
中文名:	呂佳茹				
外文名:	LU, CHIA-JU				
中文名:	張祐誠				
外文名:	CHANG, YU-CHENG				
口試日期:	2020-06-02				
學位類別:	碩士				
院校名稱:	亞洲大學				
系所名稱:					
畢業學年度:	108				
論文出版年:	2020				
學號:					
語文別:	中文				
論文頁數:	94				
中文關鍵詞:	灌溉用水污染 高污染潛勢評估 離子交換樹脂 水質改善				

1. 論文種類依實際狀況點選, 點選處見下圖
2. 紙本論文封面原「碩士論文」字樣需和系統設定的論文種類一致, 分為「碩士論文」、「碩士專業實務報告」及「碩士技術報告」(如下圖)(書背也一併修改)

研究生中文名請填與學籍系統姓名一致(尤其外籍生)

外籍生若無中文論文名稱, 請貼英文論文名稱; 外文名稱字首大寫

姓在前加逗號, 名字在後, 請大寫, 例: 王大華英文名書寫方式: WANG, DA-WA

指導教授也是口試委員, 請務必加

審定書需與口試日期一致(自 111/6/24 起因有學系對審定書上日期有不同意見, 故圖書館不複查口試日期欄位, 但仍會提醒不同處, 自行斟酌是否正確即可)

頁數為論文最後一頁頁碼或 PDF 檔總頁數皆可

1. 各關鍵字需分欄填寫。
2. 外籍生若無中文關鍵字, 請於中文關鍵字欄填入英文關鍵字。
3. 中文關鍵詞不可以全部英文



## 5. 中英文摘要

論文審查流程.docx - Microsoft Word

臺灣博碩士論文知識加值系統管理平臺 - Mozilla Firefox

ndltdcc.ncl.edu.tw/manager\_thesis\_list\_acts.php?PHPSESSID=2v4imsrknae0v9qb2d26q4u85&Pact=view&PgId=847636&dept\_id=5296&examine=3#

Nanoimprint Lithography:  
Si master molds are generally patterned by electron-beam lithography (EBL) that is known to be a time consuming nano patterning technique. Thus, developing mold duplication process based on high throughput technique such as nanoimprint lithography can be helpful in reducing its fabrication time and cost. The 17000E series negative Young's modulus is high, and a final transfer pattern is used for pattern transfer. We compare the RLT as 10-20nm, the value of 1 in a particular location means that cavities are completely filled in that region. We have achieved completely filled cavities, i.e., value of 1 at all locations. We have achieved RLT around 10nm and even RLT at all location in pattern using mr-17020E photoresist imprint. GaN GAA Nanowire:  
To increase typically low output drive currents from Si Nanowire field-effect transistors (FETs), we show a GaN based GAA Nanowire FET's effectiveness. The theoretical study is focused on the three dimensional device designs, comparisons, random dopant fluctuation using IFM, and general variability issues including nanowire length, gate work function, and channel thickness are discussed. Performance of GaN GAA Nanowire is found to be increasing as Gate length is increased. Electrical characteristics of FETs including threshold voltage saturation, On/Off current ratio and sub threshold slope (SS) are analysed. GaN GAA structure let to gate control ability improvement compared to Si based Nanowire in electrical performance. The GaN GAA Nanowire subthreshold slope is ~62mV/decade, which is close to the theoretical limit 60 mV/decade and leads to very high Ion/Off ratio of 1010-1011. The GaN GAA Nanowire is a very promising candidate for high-performance.

論文中文摘要：

Nanoimprint Lithography:  
Si master molds are generally patterned by electron-beam lithography (EBL) that is known to be a time consuming nano patterning technique. Thus, developing mold duplication process based on high throughput technique such as nanoimprint lithography can be helpful in reducing its fabrication time and cost. This study aims to develop capabilities in patterning nano structure using thermal nano-imprint lithography. The NEB22 A2, mr-17000E series negative e-beam resist possess a variety of characteristics desirable for NIL, such as low viscosity, low bulk-volumetric shrinkage, high Young's modulus, high thermal stability, and excellent dry-etch resistance. The excellent oxygen-etch resistance of the barrier material enables a final transfer pattern that is about three times higher than that of the original NIL mold. Based on these imprint on negative photo resist approach is used for pattern transfer into silicon substrates. The result is a high-resolution pattern with feature sizes in the range of nanometer to several microns. We combine Simprint Core simulation software for simulating nanoimprint process and to achieve uniform RLT. Our research results in low RLT as 10-20nm thicknesses for mr-17020E photoresist. The simulation results and experimental results are matching. A plot of how RLT across the whole stamp region changes with imprinting duration is shown using simulation. The central, thick line shows the average RLT across the entire stamp; the thin lines indicate the stamp-average RLT plus and minus one standard deviation of the cross-stamp RLT values. Simulated and calibrated for uniform residual layer thickness (RLT) and the cross-sections of RLT are plotted. In cavity filling value of 0 denotes completely empty cavities; a value of 1 in a particular location means that cavities are completely filled in that region. We have achieved completely filled cavities, i.e., value of 1 at all locations. We have achieved RLT around 10nm and even RLT at all location in pattern using mr-17020E photoresist imprint. GaN GAA Nanowire:  
To increase typically low output drive currents from Si Nanowire field-effect transistors (FETs), we show a GaN based GAA Nanowire FET's effectiveness. The theoretical study is focused on the three dimensional device designs, comparisons, random dopant fluctuation using IFM, and general variability issues including nanowire length, gate work function, and channel thickness are discussed. Performance of GaN GAA Nanowire is found to be increasing as Gate length is increased. Electrical characteristics of FETs including threshold voltage saturation, On/Off current ratio and sub threshold slope (SS) are analysed. GaN GAA structure let to gate control ability improvement compared to Si based Nanowire in electrical performance. The GaN GAA Nanowire subthreshold slope is ~62mV/decade, which is close to the theoretical limit 60 mV/decade and leads to very high Ion/Off ratio of 1010-1011. The GaN GAA Nanowire is a very promising candidate for high-performance.

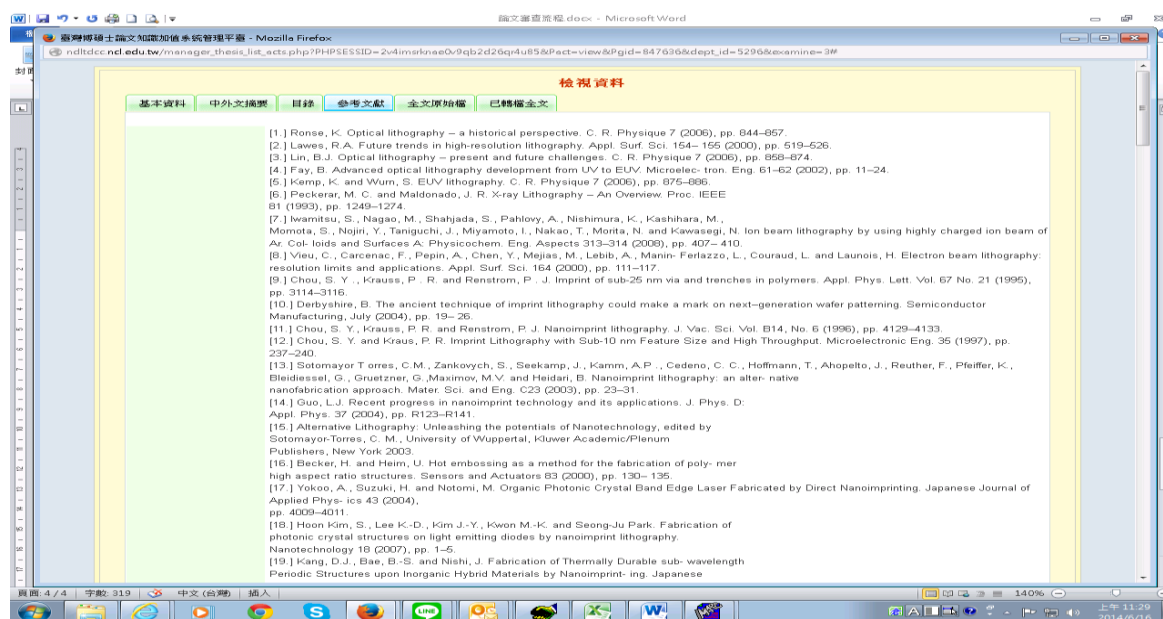
論文外文摘要：

1. 本欄只要摘要，不需貼上關鍵字。
2. 外籍生若無中文摘要，請於該欄貼上英文摘要。

## 6. 確認貼上目錄/圖目錄/表目錄

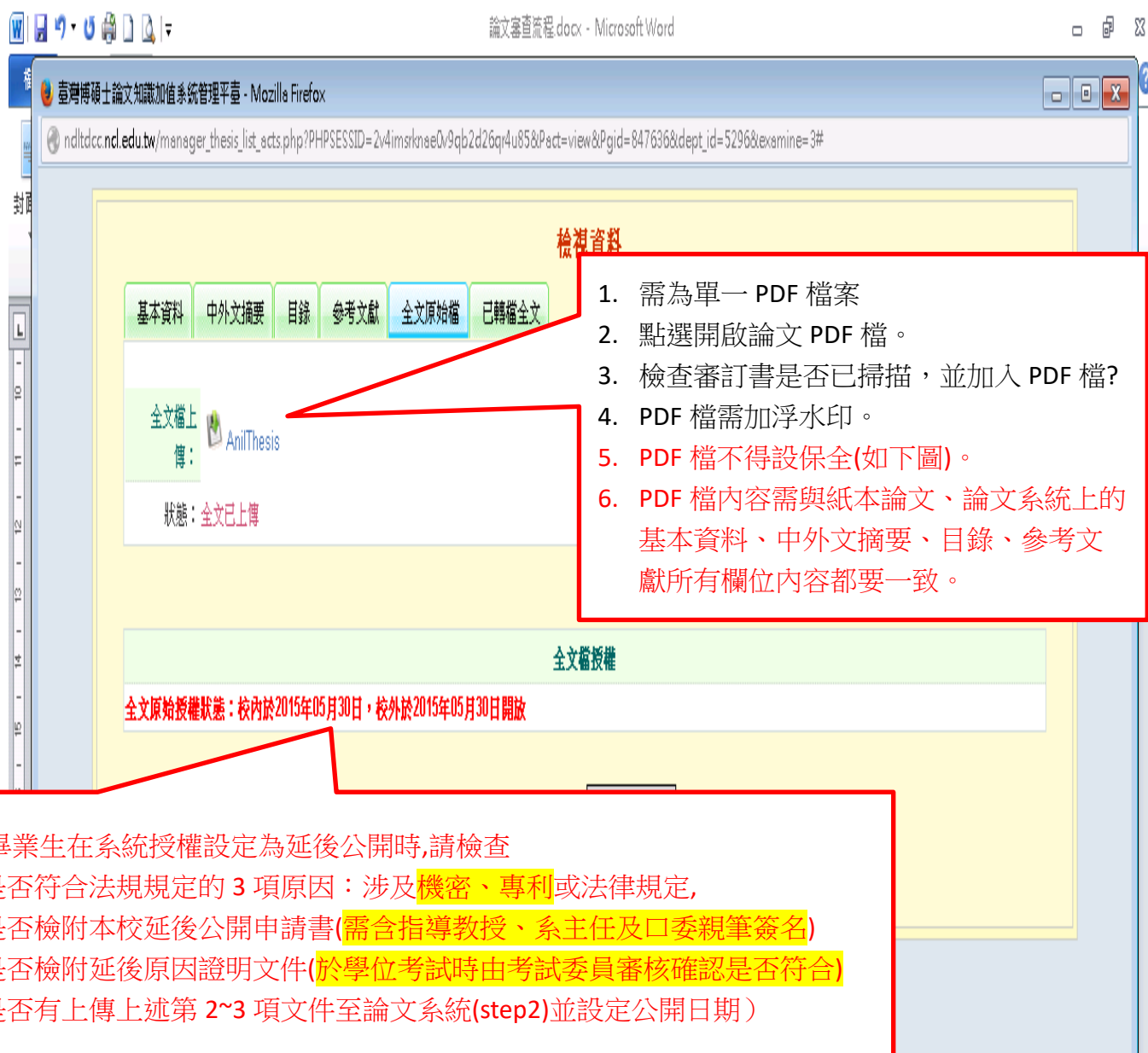
1. 確認目錄/圖目錄/表目錄是否均貼上?  
2. 抽驗紙本及電子檔論文頁碼是否一致且正確?  
例如:第四章在第 69 頁, 請查 PDF 檔的第四章頁碼是否為 69?

## 7. 參考文獻查核





## 8. 全文 PDF 檔查核



檢核資料

1. 需為單一 PDF 檔案
2. 點選開啟論文 PDF 檔。
3. 檢查審訂書是否已掃描，並加入 PDF 檔？
4. PDF 檔需加浮水印。
5. PDF 檔不得設保全(如下圖)。
6. PDF 檔內容需與紙本論文、論文系統上的基本資料、中外文摘要、目錄、參考文獻所有欄位內容都要一致。

全文檔上傳

狀態：全文已上傳

全文檔授權

全文原始授權狀態：校內於2015年05月30日，校外於2015年05月30日開放

若畢業生在系統授權設定為延後公開時,請檢查

- 1)是否符合法規規定的 3 項原因：涉及機密、專利或法律規定,
- 2)是否檢附本校延後公開申請書(需含指導教授、系主任及口委親筆簽名)
- 3)是否檢附延後原因證明文件(於學位考試時由考試委員審核確認是否符合)
- 4)是否有上傳上述第 2~3 項文件至論文系統(step2)並設定公開日期)

\*電子全文已設保全圖示



9. 授權書查核(1 張):紙本及掃描成 PDF 檔上傳系統

(1) 紙本授權書(1張)查核

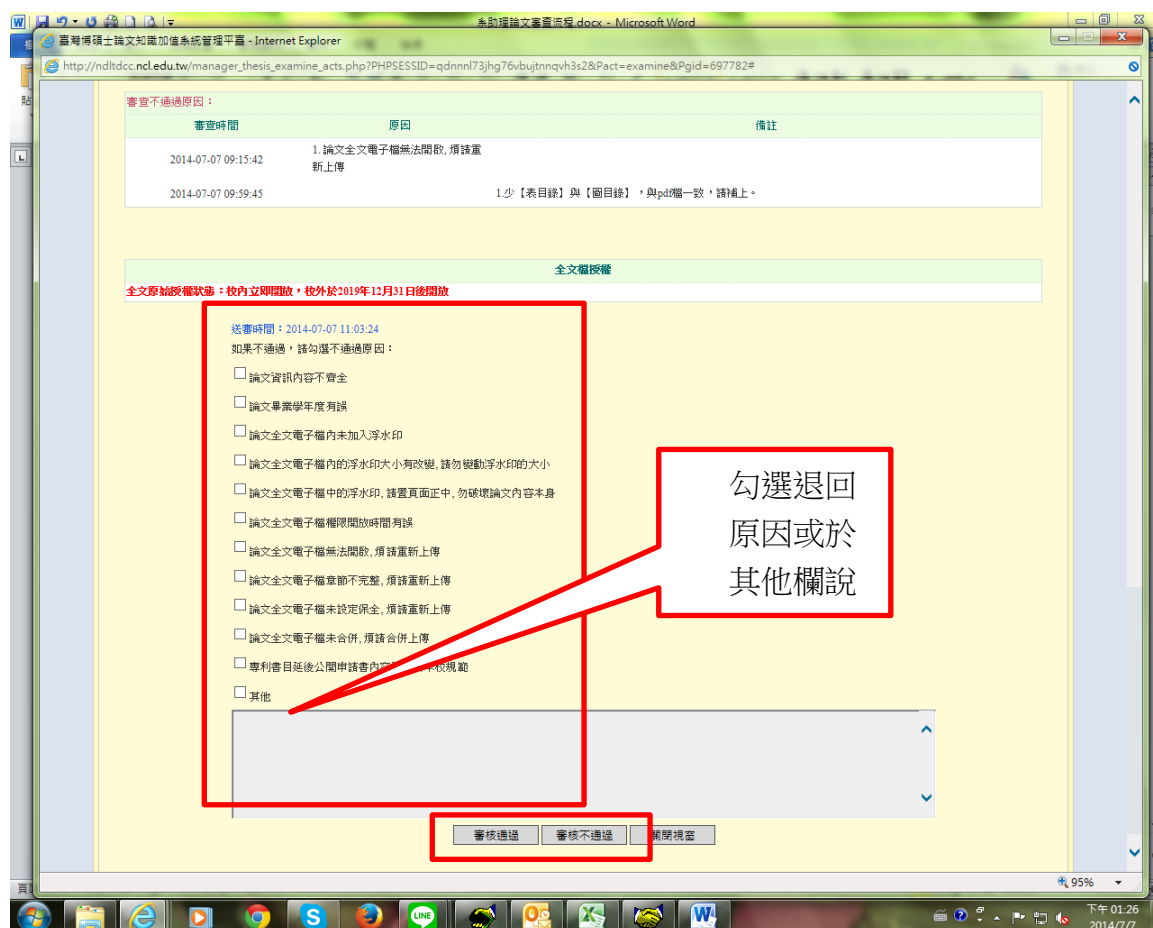
[illegible]

1. 本授權書限由系統產生**共 1 張**。
2. 授權書 ID 前導碼需與學年度相符,例:109 學年,ID 前導碼為 **109**。
3. 需指導教授及研究生需本人簽名。
4. 日期欄要填**(授權書日期需介於論文口試到學校教務處規定離校時程之間)**。
5. 有任何修改,均需於修改處蓋章。

- (2) 簽署完成之授權書完成系統上傳 PDF 檔查核:研究生基本資料下方”學位論文授權書”點選”查看”
- (3) 若遇有審核退回情形,系統預設會刪除原本已上傳之授權書,研究生必需重新上傳簽署完成之授權書,系助也必需再查核 1 次是否有上傳



# 10. 審核結果：點選「審核通過」或「審核不通過」



11. 紙本論文：檢查膠裝、封面（膠膜）、書背及封面顏色（雲彩紙，顏色有統一，圖例請至論文系統→下載區第 8 項）；紙本論文不需浮水印。
12. 依國家圖書館規定學位論文內不應含個人資訊，如電子郵件、電話、住址、身分證字號等，應抽出或隱蔽。



## 13. 申請延後公開注意事項(若無可跳過)

- (1) 依「亞洲大學學位論文管理要點」第六條，延後公開原因限於涉及**機密、專利，或依法律規定**而必須延後者。
- (2) 延後年限：至多以**5年**為限，如有特殊需要，需逐次申請。
- (3) 申請延後公開審核程序：研究生應填具「亞洲大學學位論文延後公開申請書」(至論文系統下載區下載最新版)，註明延後公開原因及檢附相關證明文件，於進行學位考試前向所屬學系提出申請，並於學位口試時由口試委員審核確認是否合上述原因後簽名。
- (4) 延後公開期間：
  - 甲、每次申請電子全文及紙本論文延後公開至多以**5年**為限，如有特殊需要，需逐次申請。
  - 乙、**第2次起之申請程序**，仍應取得原所有學位考試委員審核確認，或經原就讀系所之系（所）務等會議審核確認。
- (5) 申請延後公開辦理離校論文審查時需繳交之證明文件
  - 甲、「亞洲大學學位論文延後公開申請書」1份(經由畢業生、指導教授、學系主管及**口試委員**親筆簽名)。
  - 乙、延後原因之相關證明文件，
    - i. 涉及機密:提供相關單位開立該論文內容涉及機密之證明影本。
    - ii. 專利事項:填寫專利申請案號，提供申請專利單位回覆之影本。
    - iii. 依法不得提供:填寫原因並檢附證明文件，例如論文之研究與公司或研究機構簽訂保密合約，提供保密合約的影本。
  - 丙、**將上述文件掃描**上傳至論文系統「step2 上傳全文」→「有申請紙本文延後公開者請點選此按鈕」→設定延後公開日期。
  - 丁、於到圖書館辦理論文複核時，將申請書及相關證明文件正本繳交至圖書館。
- (6) 審查時需注意
  - 甲、系統設定延後公開日期是否與上傳之申請書（請點選日期下方磁片圖示查看）一致。
  - 乙、需確認上傳之申請書各項欄位是否填寫完成、申請人/指導教授/系主任/**口試委員**需親筆簽名及系所章戳用印完成，另證明文件是否已上傳。

建檔論文維護

系所: / 論文編號: 學年度: 請選擇 研究生: 學號: 查詢

論文狀態: 審核通過 論文名稱: 有

論文編號	論文名稱	姓名	全文	書目延後公開/專利	狀態	動作
1	105T			2020-06-02	審核通過	檢視

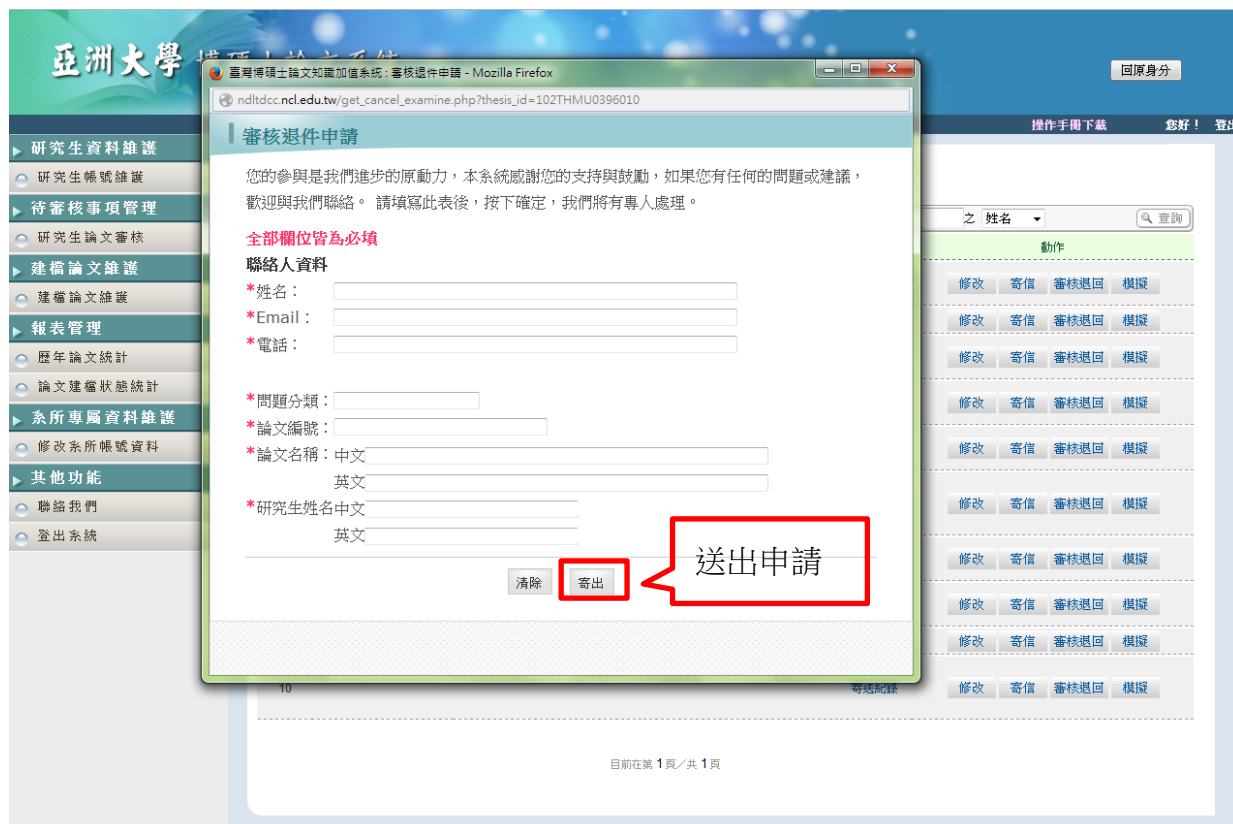
## 14. 論文退件處理

當系助理已將研究生論文審核通過，但論文仍需修改時，則需向國家圖書館申請退件，申請退件步驟如下：

(1) 在研究生帳號後點選「審核退回」



(2) 送出申請(通常國圖約 10-20 分鐘內處理完畢)(PS.國圖系統人員六日不上班)



## 15. 當學期預計畢業但未畢業之研究生帳號應刪除：

- (1) 為使資訊正確，**請務必確認學生已符合畢業資格(如已修完學校規定學分)**及於研究生口試完，且論文修正完成後再核發系統帳號及密碼；
- (2) 在教務處規定的論文繳交時程結束後，請將因故無法於該學期畢業之論文系統研究生帳號刪除。



## 16. 其他:

- (1) 置於本校論文系統→建檔說明→論文格式規範→各系所屬之論文格式規範 Department Thesis Format List, **請各系若有更新者,回傳連結給我,以便一併更新網頁.**

